

제20회 한국반도체학술대회

2013년 2월 4일(월)~6일(수) / 웰리힐리파크 (구, 성우리조트)

우) 302-120 대전광역시 서구 둔산동 1018번지 대한빌딩 5층 / 담당: 최은영 팀장, 김아영
TEL: (042) 472 -7461 FAX: (042) 472 -7459 E-mail: kcs@cosar.or.kr

Q. Metrology, Inspection, and Yield Enhancement 분과

Room E

스타홀 (본관, 2층)

2013년 2월 5일(화) 15:15-16:30

[TE3-Q] Metrology & Inspection

좌장: 김호섭(선문대학교), 유형원(SK 하이닉스)

[초청]

- | | | |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TE3-Q-1 | 15:15-15:45 | Nanometrology: Important Role for Understanding the Charge Transport Phenomena in Emerging Electronic Devices
박경수
삼성전자 종합기술원 AS 그룹 |
| TE3-Q-2 | 15:45-16:00 | Strain Characterization of SiGe Source/Drain Structures After Annealing Process by Nano Beam Electron Diffraction
Sun-Wook Kim ¹ , Dae-Seop Byeon ¹ , Dae-Hong Ko ¹ , and Hoo-Jeong Lee ²
¹ Department of Materials Science and Engineering, Yonsei University,
² Department of Advanced Materials Science and Engineering, Sungkyunkwan University |
| TE3-Q-3 | 16:00-16:15 | HRTEM과 HAADF-STEM 기법을 이용한 $In_xGa_{1-x}N$ MQW의 정밀미세 구조 분석 및 조성의 정량적 평가
양준모 ¹ , 박중식 ^{1,3} , 박경진 ¹ , 박윤창 ¹ , 유정호 ¹ , 정철성 ¹ , 이상결 ² , 신기삼 ³
¹ 나노종합팩센터, ² 한국기초과학지원연구원,
³ 창원대학교 나노신소재공학과 |
| TE3-Q-4 | 16:15-16:30 | 노광량에 따른 EUV 레지스트 막의 표면거칠기 측정
박병천 ¹ , 조용재 ¹ , 여정호 ² , 김인성 ²
¹ 한국표준과학연구원, ² 삼성전자 메모리 사업부 |